

С д е л а н о в С С С Р

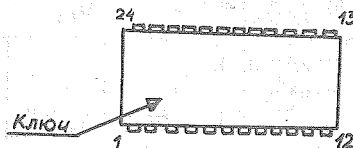
Э Т И К Е Т К А

МИКРОСХЕМА ТИПА К573РФ2 (27 76)

Постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации, с длительным сроком хранения информации при включенном или отключенном напряжении питания.

Число информационных слов - 2048, число разрядов в информационном слове - 8.

Схема расположения выводов



Обозначение выводов показано условно.
Форма ключа не регламентируется.

Масса не более 5 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Напряжение низкого уровня сигнала выходной информации, V	не более 0,4
Напряжение высокого уровня сигнала выходной информации, V	не менее 2,4
Время хранения информации при включенном напряжении питания, h	не менее 25000
Время хранения информации при отключенном напряжении питания, h	не менее 100000
Время выборки адреса, μ s	не более 0,45
Количество циклов перепрограммирования, цикл	не менее 100

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра, режим, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а			
		предельно допустимый режим		предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение низкого уровня входных сигналов, U	$U_{DIL}, U_{AL}, U_{CEL}, U_{SEL}$	-	0,4	-0,3	0,8
Напряжение высокого уровня входных сигналов, U	$U_{OEN}, U_{DIN}, U_{AH}, U_{SEN}$	2,4	-	2,0	6,0
Напряжение питания, U	U_{CC}	4,75	5,25	-0,3	6,0
Напряжение сигнала записи высокого уровня, U	U_{WRH}	23,5	25,5	-0,3	26,0
Напряжение сигнала записи низкого уровня, U	U_{WRL}	4,75	5,25	-0,3	6,0
Температура хранения микросхем, К	T	228	349	213	398

Примечания: 1. Значения напряжения даны относительно вывода I2.

2. После хранения микросхем при предельной температуре 398К информацию необходимо стереть и записать вновь.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функциональное состояние микросхемы	Функциональное назначение и номер вывода				
	"Вход адресный" (8-1, 19, 22, 23)	"Вход сигнала разрешения обращения" (18)	"Вход сигнала разрешения выхода" (20)	"Вход сигнала записи-считывания" (21)	"Выход-вход" (9-11, 13-17)
Считывание информации	U_{AL}, U_{AH}	U_{SEL}	U_{OEL}	U_{WRL}	U_{DOL} при $I_{OL} \geq 2,1 \text{ mA}$ U_{DOL} при $I_{OL} < 0,4 \text{ mA}$
Невыбор микросхемы	Произвольно	U_{SEL}	U_{OEL}	U_{WRL}	Состояние "Выключено"
Снижение потребляемой мощности	Произвольно	U_{SEL}	Произвольно	U_{WRL}	Состояние "Выключено"
Программирование (запись)	U_{AL}, U_{AH}	Импульс U_{SEN}	U_{OEN}	U_{WRH}	U_{DIL}, U_{DIN}
Контроль после программирования	U_{AL}, U_{AH}	U_{SEL}	U_{OEL}	U_{WRH}	U_{DOL} при $I_{OL} \geq 2,1 \text{ mA}$ U_{DOL} при $I_{OL} < 0,4 \text{ mA}$
Запрет программирования (записи)	Произвольно	U_{SEL}	U_{OEN}	U_{WRH}	Состояние "Выключено"
Стирание информации	Облучение кристалла микросхемы УФ-излучением $\lambda \leq 400 \text{ nm}$ с энергией преимущества излучения на $\lambda = 253,7 \text{ nm}$. Температура корпуса при этом не более 343 К.				

Примечание: $U_{AL}=U_{SEL}=U_{OEL}=(0-0,4)\text{V}$; $U_{AH}=U_{SEN}=U_{OEN}=(2,4-5,25)\text{V}$; $U_{CC}=U_{WRL}=5 \text{ V} \pm 5\%$; $U_{WRH}=(23,5-25,5)\text{V}$.

Вывод 24 - U_{CC} .